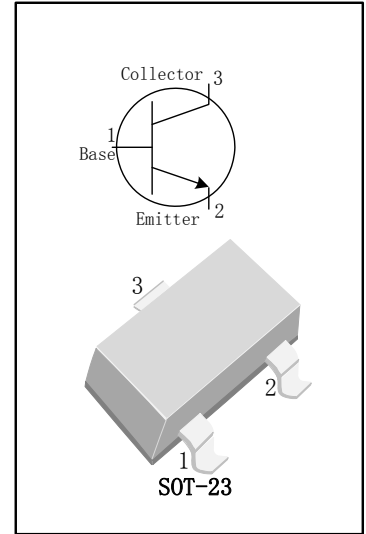


**2SC3585NPN TRANSISTOR (NPN)
MICROWAVE LOW NOISE AMPLIFIER
NPN SILICON EPITAXIAL TRANSISTOR**

简述:

- 本芯片采用硅外延工艺制造;
- 具有高功率增益放大以及低噪声特性;
- 大动态范围, 理想的电流线性;
- 主要应用于超高频微波、VHF、UHF 和 CATV 高频宽带低噪声放大器;
- 可替代进口同类型号的 2SC3585, 其性能指标均相同;
- 封装形式: SOT-23;
- 集电极-基极击穿电压: $BV_{CBO}=20V$, 集电极电流: $I_C=50mA$, 集电极功率: $P_C=200mW$, 特征频率: $f_T=9GHz$.



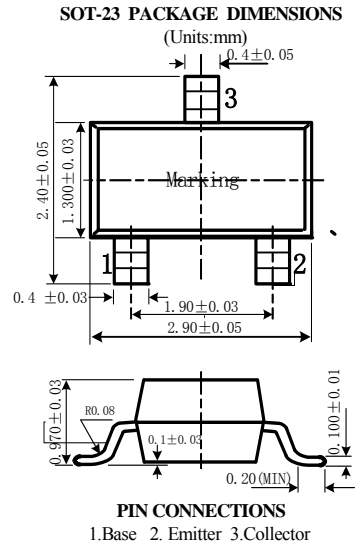
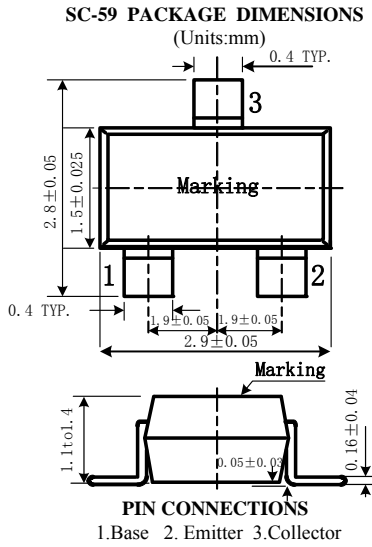
极限参数 (Tamb=25°C) :

参数名称	符号	额定值	单位
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	20	V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	10	V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	2	V
集电极电流	I_C	35	mA
耗散功率	P_T	200	mW
最高结温	T_J	150	°C
储存温度	T_{stg}	-65 ~ +150	°C

电参数及规格 (Tamb=25°C) :

参数名称	符号	测试条件	额定值			单位
			最小值	典型值	最大值	
集电极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=10V, I_E=0$	-	-	0.1	μA
发射极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=1.0V, I_C=0$	-	-	1.0	μA
直流电流放大系数	h_{FE}	$V_{CE}=6V, I_C=10mA$	50	100	250	
特征频率	f_T	$V_{CE}=6V, I_C=10mA$	-	9	-	GHz
反馈电容	C_{re}	$I_C=i_c=0, V_{CB}=6V, f=1MHz$	-	0.3	0.8	pF
插入功率增益	$ S_{21} ^2$	$I_C=10mA, V_{CE}=6V, f=2GHz$	6.0	8.0	-	dB
噪声系数	NF	$V_{CE}=6V, I_C=5mA, f=2GHz$	-	1.8	3.0	dB

CLASSIFICATION OF h_{FE}			
Rank	R43	R44	R45
Range	50~100	80~160	125~250
Marking	R43	R44	R45



包装信息 PACKAGE INFORMATION

Package	Shipping	Inner Box	Carton
SC-59	3000pcs/Tape&Reel	5 Tape&Reel	12 Inner Box
SOT-23	3000pcs/Tape&Reel	10 Tape&Reel	6 Inner Box